

# RB100A

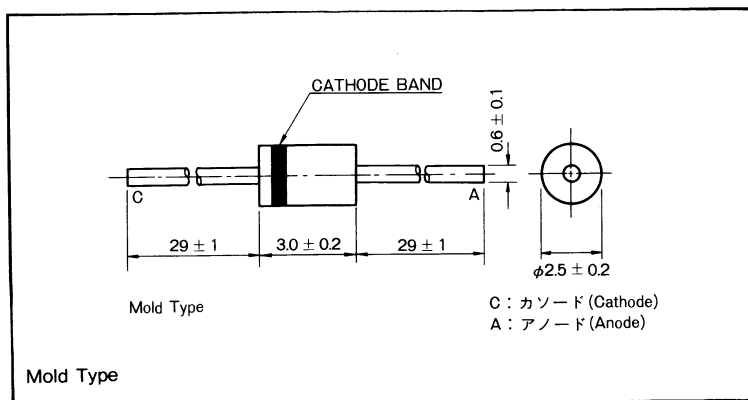
シリコンエピタキシャル形一般用整流ショットキーバリアダイオード  
(モールドタイプ)

Silicon Epitaxial General Use Rectifying Schottky Barrier Diode (Mold Type)

RB100Aは、順方向抵抗が小さく、逆回復時間  $T_{rr}$  が小さいことから、低損失高周波を整流するDC-DCコンバータやスイッチング電源用として適しています。小型軽量でしかも5mmピッチ挿入に対応できます。

RB100A is suitable for use in DC-DC converter rectifying low-dissipating high-frequency, or power supply of switching due to its small forward resistance and short reverse recovery time. Small size, light weight and corresponds to inserting 5mm pitch.

## ● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



## ● カソードバンド色別/Cathode Band Color

Type	Color
RB100A	Blue

## ● 特長

- 1) 小型である。
- 2) 高信頼性である。
- 3) 順方向電圧降下が小さい。

## ● Features

- 1) Small size.
- 2) High reliability.
- 3) Small drop of forward voltage.

## ● 用途

高周波整流用  
スイッチング電源用

## ● Applications

High-frequency rectification  
Power supply of switching

## ● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Type	ピーク繰り返し逆電圧 $V_{RM}$ (V)	平均整流電流 $I_O$ (A)	尖頭順サージ電流 (60Hz, 1~) $I_{FSM}$ (A)	接合部温度 $T_j$ (°C)	保存温度 $T_{stg}$ (°C)
RB100A	40	1	40	-40~125	-40~125

## ● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Type	順電圧		逆電流	
	$V_F$ (V) Max.	Cond. $I_F$ (A)	$I_R$ (μA) Max.	Cond. $V_R$ (V)
RB100A	0.55	1	1000	40

## ● 標準品・準標準品一覧表 (◎:標準品 ○:準標準品)

Type	包装名	バルク		テーピング	
				52mm	26mm
	記号			T-31	T-32
	基本発注単位(個)	1 000	2 500	2 500	
RB100A		◎	◎	◎	

● 電気的特性曲線 / Electrical Characteristic Curves

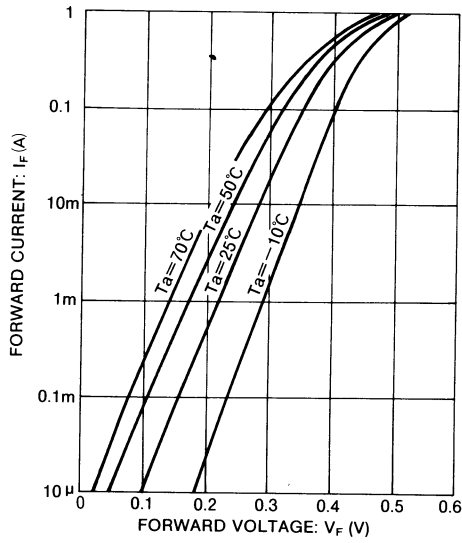


Fig. 1 順方向温度特性

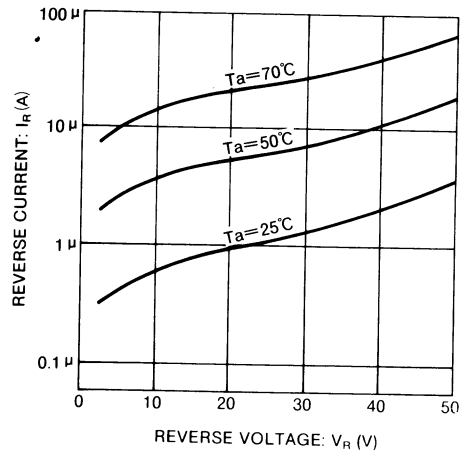


Fig. 2 逆方向温度特性

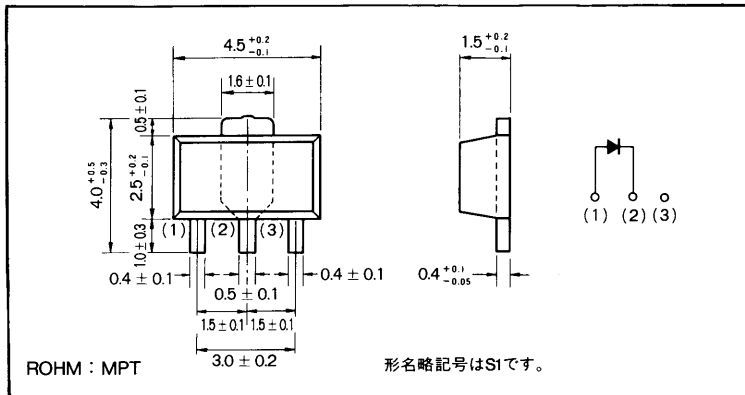
# RB110C

## シリコンエピタキシャル形一般用整流ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial General Use Rectifying Shottky Barrier Diode

RB110Cは、順方向抵抗が小さく、逆回復時間Trrが小さいことから、低損失高周波を整流するDC-DCコンバータやスイッチング電源用として適しています。

RB110C is suitable for use in DC-DC converter rectifying low-dissipating high-frequency, or power supply of switching due to its small forward resistance and short reverse recovery time.

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 特長

- 1) 小型である。
- 2) 高信頼性である。
- 3) 順方向電圧降下が小さい。

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

Type	ピーク繰り返し逆電圧 V <sub>RM</sub> (V)	平均整流電流 I <sub>O</sub> (A)	尖頭順サージ電流 (60Hz, 1~) I <sub>FSM</sub> (A)	接合部温度 T <sub>J</sub> (°C)	保存温度 T <sub>stg</sub> (°C)
RB110C	40	1	5	-40~125	-40~125

● Features

- 1) Small size.
- 2) High reliability.
- 3) Small drop of forward voltage.

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta=25°C)

Type	順電圧		逆電流	
	V <sub>F</sub> (V) Max.	Cond. I <sub>F</sub> (A)	I <sub>R</sub> (μA) Max.	Cond. V <sub>R</sub> (V)
RB110C	0.60	1	80	25

● 用途

高周波整流用  
スイッチング電源用

● Applications

High-frequency rectification  
Power supply of switching

# RB400D

## シリコンエピタキシャル形一般整流ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial General Use Rectifying Schottky Barrier Diode

RB400Dは、順方向抵抗が小さく、逆回復時間 $T_{rr}$ が小さいことから、低損失高周波を整流するDC-DCコンバータやスイッチング電源用として適しています。

RB400D is suitable for use in DC-DC converter rectifying low-dissipating high-frequency, or power supply of switching due to its small forward resistance and short reverse recovery time.

### ● 特長

- 1) 小型である。
- 2) 高信頼性である。
- 3) 順方向電圧降下が小さい。

### ● Features

- 1) Small size.
- 2) High reliability.
- 3) Small drop of forward voltage.

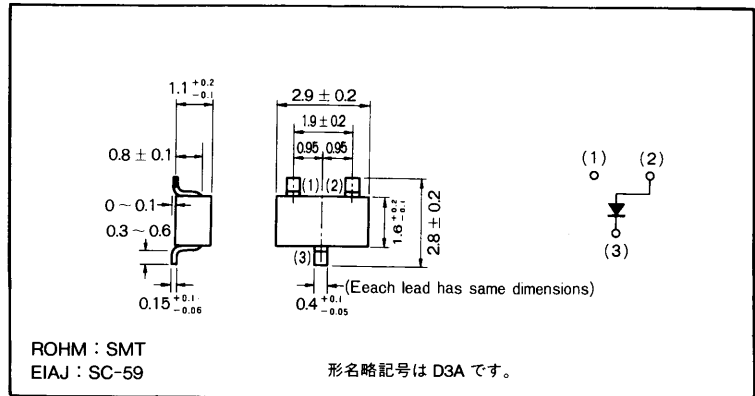
### ● 用途

高周波整流用  
スイッチング電源用

### ● Applications

High-frequency rectification  
Power supply of switching

### ● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



### ● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Type	ピーク繰り返し 逆電圧 $V_{RM}(V)$	平均整流電流 $I_O(A)$	尖頭順サージ電流 (60Hz, 1 $\sim$ ) $I_{FSM}(A)$	接合部温度 $T_j(^\circ\text{C})$	保存温度 $T_{stg}(^\circ\text{C})$
RB400D	20	0.5	3	-40~125	-40~125

### ● 電気的特性/Electrical Characteristics ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Type	順電圧		逆電流	
	$V_F(V)$ Max.	Cond. $I_F(A)$	$I_R(\mu A)$ Max.	Cond. $V_R(V)$
RB400D	0.55	0.5	30	10

● 電気的特性曲線 / Electrical Characteristic Curves

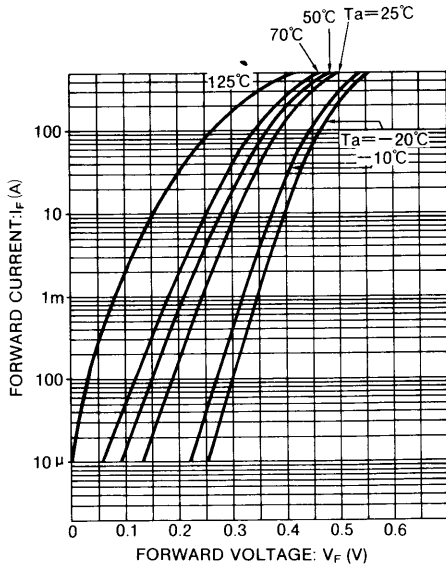


Fig. 1 順方向温度特性

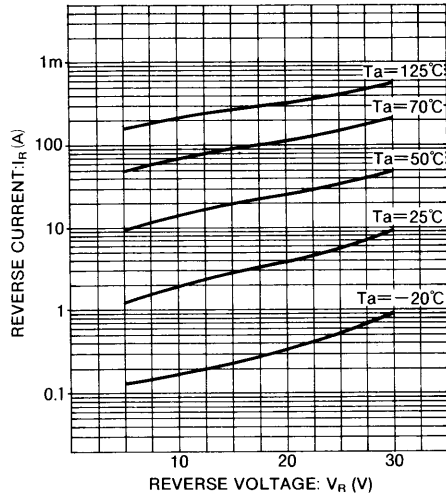


Fig. 2 逆方向温度特性

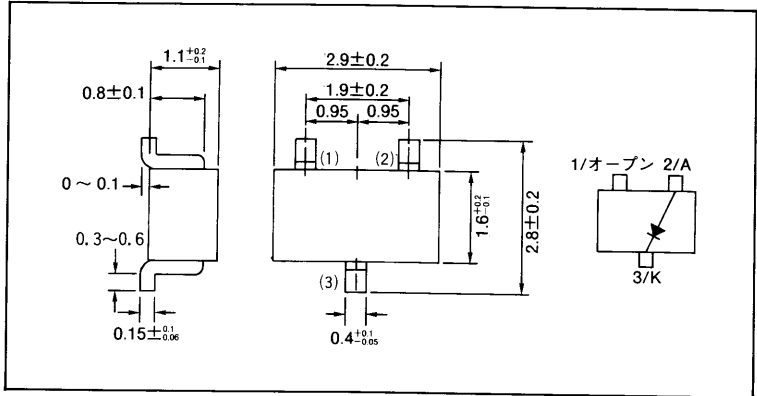
# RB411D

## シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 特長

- 1) ミニモールドタイプ。
- 2) 小型である。
- 3) 高信頼度である。

● 外形寸法図 / Dimensions (Unit : mm)



● Features

- 1) Minimold type
- 2) Small size
- 3) High reliability

● 用途

小電力整流用

● Applications

For rectifying small power

● 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V <sub>RM</sub>	20	V
逆方向電圧	V <sub>R</sub>	10	V
平均整流電流	I <sub>O</sub>	0.5	A
尖頭サージ電流*	I <sub>FSM</sub>	3	A
動作接合温度範囲	T <sub>j</sub>	-40 ~ +125	°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +125	°C

\*60Hz・1~

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I <sub>R</sub>	—	—	30	μA	V <sub>R</sub> = 10V
順方向電圧	V <sub>F1</sub>	—	—	0.3	V	I <sub>F</sub> = 10mA
	V <sub>F2</sub>	—	—	0.5	V	I <sub>F</sub> = 500mA
端子間容量	C <sub>t</sub>	—	20	—	pF	V <sub>R</sub> = 10V, f = 1MHz

# RB420D

## シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 特長

- 1) ミニモールドタイプ。
- 2) 小型である。
- 3) 高信頼度である。

● Features

- 1) Minimold type
- 2) Small size
- 3) High reliability

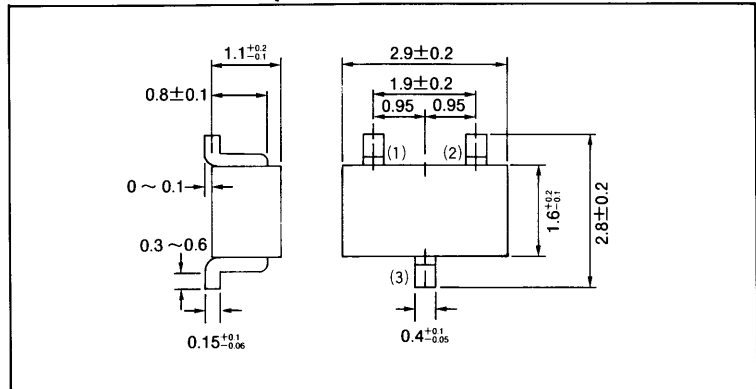
● 用途

小電力整流用

● Applications

For rectifying small power

● 外形寸法図 / Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V <sub>RM</sub>	25	V
直流逆電圧	V <sub>R</sub>	20	V
平均整流電流	I <sub>O</sub>	0.1	A
尖頭サージ電流*	I <sub>FSM</sub>	1	A
動作接合温度範囲	T <sub>j</sub>	-40 ~ +125	°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +125	°C

\*60Hz・1〜

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I <sub>R</sub>	—	—	1	μA	V <sub>R</sub> = 10V
順方向電圧	V <sub>F</sub>	—	—	0.45	V	I <sub>F</sub> = 10mA
端子間容量	C <sub>t</sub>	—	6.0	—	pF	V <sub>R</sub> = 10V, f = 1MHz

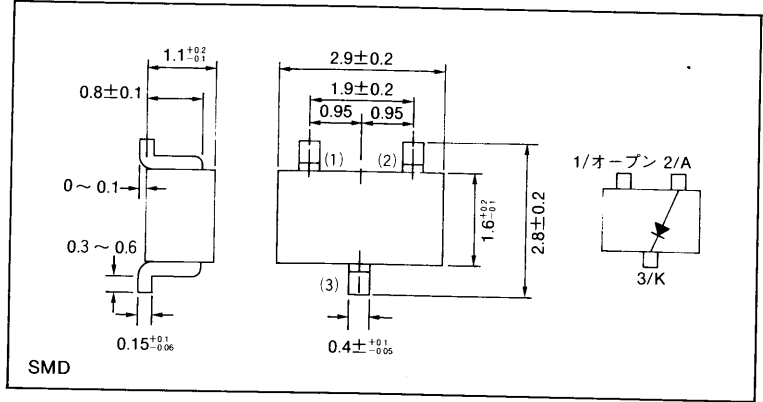
# RB421D

## シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 特長

- 1) ミニモールドタイプ。
- 2) 小型である。
- 2) 高信頼度である。

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● Features

- 1) Minimold type
- 2) Small size
- 3) High reliability

● 用途

小電流整流用

● Applications

For rectifying small current

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
尖頭逆方向電圧	V <sub>RM</sub>	20	V
直流逆方向電圧	V <sub>R</sub>	10	V
平均整流電流	I <sub>O</sub>	0.1	A
尖頭サージ電流*	I <sub>FSM</sub>	1	A
動作接合温度範囲	T <sub>j</sub>	-40 ~ +125	°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	-40 ~ +125	°C

\*60Hz・1 ~

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I <sub>R</sub>	—	—	30	μA	V <sub>R</sub> = 10V
順方向電圧	V <sub>F1</sub>	—	—	0.55	V	I <sub>F</sub> = 100mA
	V <sub>F2</sub>	—	—	0.34	V	I <sub>F</sub> = 10mA
端子間容量	C <sub>t</sub>	—	6.0	—	pF	V <sub>R</sub> = 10V, f = 1MHz



● 電気的特性曲線 / Electrical Characteristic Curves

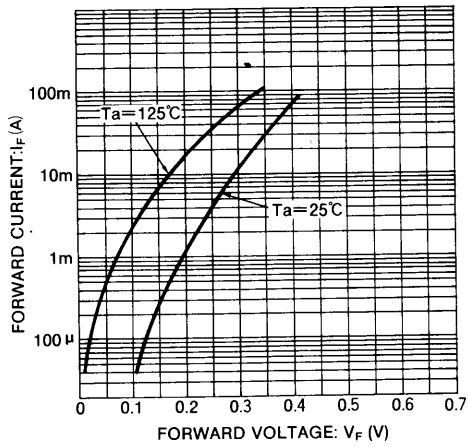


Fig. 1 順方向温度特性

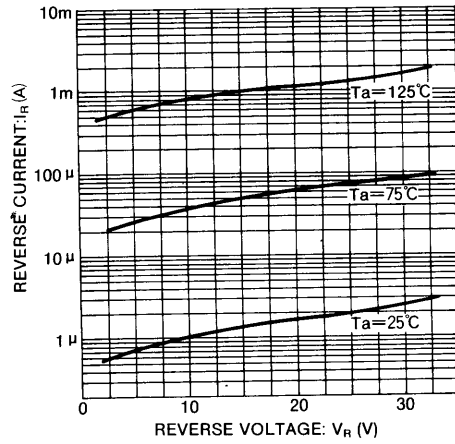


Fig. 2 逆方向温度特性

# RB425D (開発中/Under Development)

## シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 特長

- 1) ミニモールドタイプ。
- 2) 小型である。
- 3) 高信頼度である。

● Features

- 1) Minimold type
- 2) Small size
- 3) High reliability

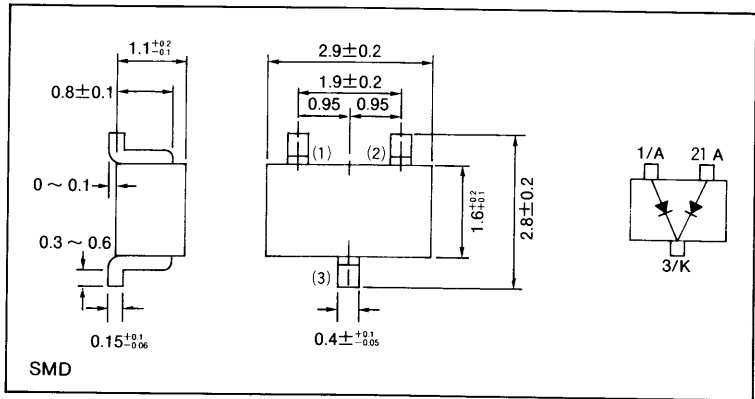
● 用途

小電流整流用

● Applications

For rectifying small current

● 外形寸法図 / Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V <sub>RM</sub>	20	V
平均整流電流*1	I <sub>O</sub>	0.1	A
尖頭サージ電流*2	I <sub>FSM</sub>	1	A
動作接合温度範囲	T <sub>j</sub>	- 40 ~ + 125	°C
保存温度範囲	T <sub>stg</sub>	- 40 ~ + 125	°C

\*1 片側負荷の場合

\*2 60Hz・1 ~

● 電気的特性 / Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I <sub>R</sub>	—	—	30	μA	V <sub>R</sub> = 10V
順方向電圧	V <sub>F1</sub>	—	—	0.55	V	I <sub>F</sub> = 100mA
	V <sub>F2</sub>	—	—	0.34	V	I <sub>F</sub> = 10mA
端子間容量	C <sub>t</sub>	—	6.0	—	pF	V <sub>R</sub> = 10V, f = 1MHz